

シリコンチャンネルMOS形電界効果トランジスタ

2SK405

○ 低周波電力増幅用

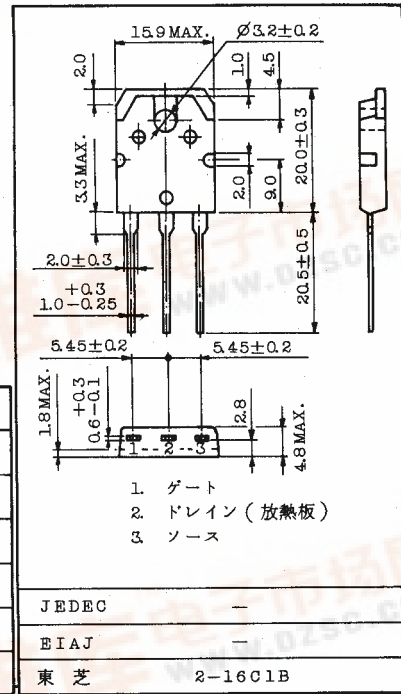
単位: mm

特長

- ・ 高耐圧です。 : $V_{DSS} = 160V$
- ・ 高順方向伝達アドミタンスです。 : $|Y_{fs}| = 2.0S$ (標準)
- ・ 2SJ115 とコンプリメンタリになります。

最大定格 (Ta = 25°C)

| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 |
|------------------|-----------|---------|----|
| ドレイン・ソース間電圧 | V_{DSS} | 160 | V |
| ゲート・ソース間電圧 | V_{GSS} | ±20 | V |
| ドレイン電流 | I_D | 8 | A |
| 許容損失 (Tc = 25°C) | P_D | 100 | W |
| チャンネル温度 | T_{ch} | 150 | °C |
| 保存温度 | T_{stg} | -55~150 | °C |



電気的特性 (Ta = 25°C)

| 項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---------------|-------------------|--------------------------------------|-----|-----|------|----|
| ゲート漏れ電流 | I_{GSS} | $V_{DS} = 0, V_{GS} = \pm 20V$ | — | — | ±1.0 | μA |
| ドレイン・ソース間降伏電圧 | $V_{(BR)DSS}$ | $I_D = 5mA, V_{GS} = 0$ | 160 | — | — | V |
| ゲート・ソース間しゝ断電流 | $V_{GS(OFF)}$ (注) | $V_{DS} = 10V, I_D = 0.1A$ | 0.8 | — | 2.8 | V |
| ドレイン・ソース間飽和電圧 | $V_{DS(ON)}$ | $I_D = 5A, V_{GS} = 10V$ | — | 2.5 | 7.0 | V |
| 順方向伝達アドミタンス | $ Y_{fs} $ | $V_{DS} = 10V, I_D = 2A$ | 1.0 | 2.0 | — | S |
| 入力容量 | C_{iss} | $V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$ | — | 430 | — | pF |
| 出力容量 | C_{oss} | $V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$ | — | 260 | — | pF |
| 帰還容量 | C_{rs} | $V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$ | — | 80 | — | pF |

(注) $V_{GS(OFF)}$ 区分 O: 0.8~1.6, Y: 1.4~2.8

この製品はMOS構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。

